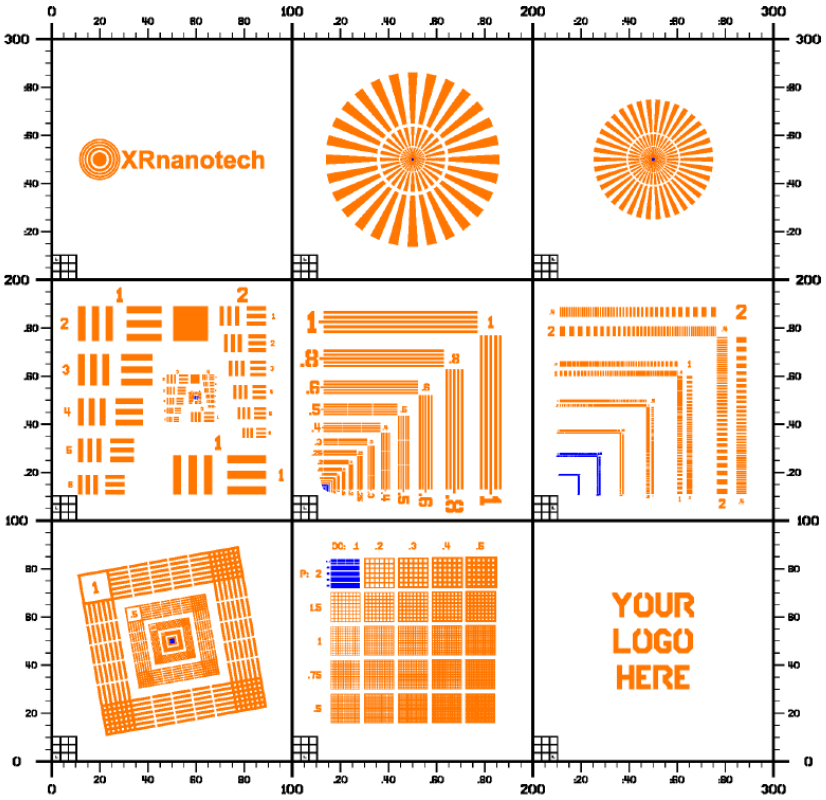
X射线纳米成像测试卡/2D Resolution Test Target

使用我们专为高精度测试任务设计的**X射线纳米成像测试卡（2D Resolution Test Target）**探索无与伦比的精度。凭借针对Gold优化的基础结构，我们的目标提供从**4μm到50nm**的分辨率，确保了出色的细节。我们还根据要求提供低至10nm的铱结构，以满足那些寻求极高精度的要求。通过先进的设计与细致的纳米制造技术的碰撞，使得我们的测试卡可以提高您的成像进度。

我们有如下规格，以满足您的具体实验要求：

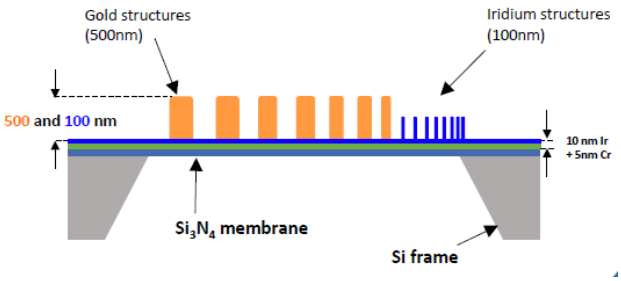
•50纳米Au：纯金结构，提供精确，高分辨率成像。
•30纳米Au/Ir Hybrid：混合材料增强细节。
•20纳米Au/Ir混合型：用于特殊成像需求的超精细结构。
•10纳米Au/Ir混合结构：我们为那些推动纳米级成像极限的最精确的结构。



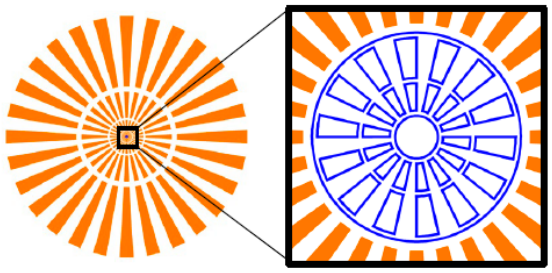
主要参数：

- 高衬度材料:500nm Au和100nm Ir
- 超宽的测试范围：0.01-4μm
- 紧凑的设计：0.3mmx0.3mm
- 图案设计和硅窗均可定制
- 保护层：厚聚合物（50nm测试卡可选）
- 质量保证：每年交付数百片

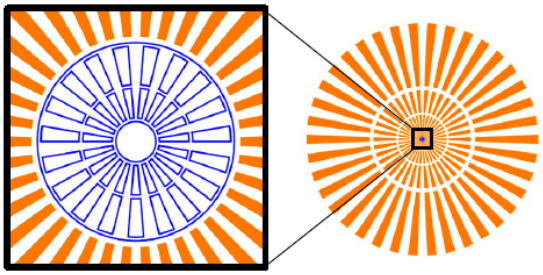
横截面图：



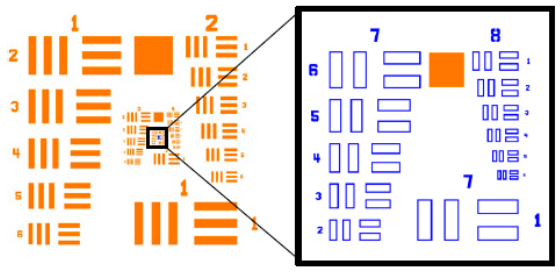
Siemens star 1: 4µm → 50 nm Au / 40nm → 10 nm Ir



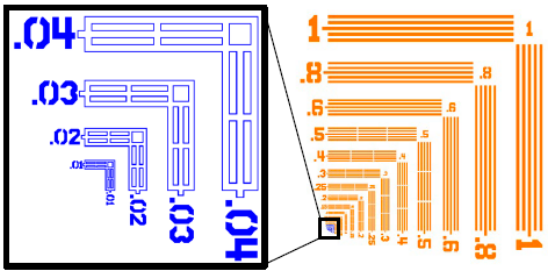
Siemens star 2: 2µm → 50 nm Au / 40nm → 10 nm Ir



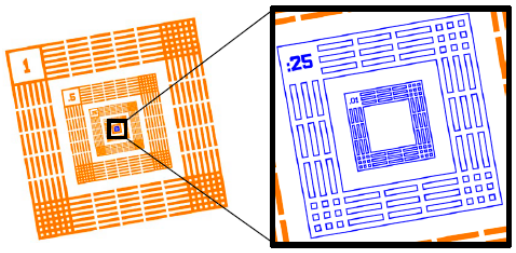
USAF 1951: 0.156 → 10 LP/µm Au / 10 → 50 LP/µm Ir



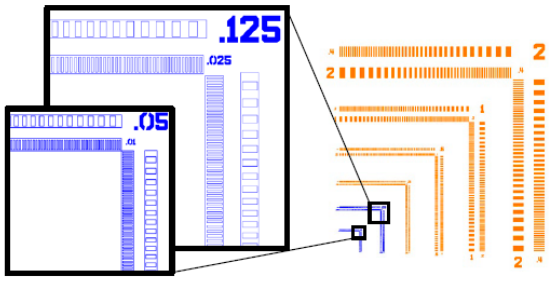
Nested-L: 1µm → 50 nm Au / 40nm → 10 nm Ir



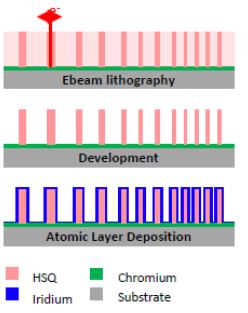
Titled grating: 1000, 500, 250, 120, 50nm Au / 25, 10 nm Ir



VLS 1D grating: 2µm → 50 nm Au / 125nm → 10 nm Ir



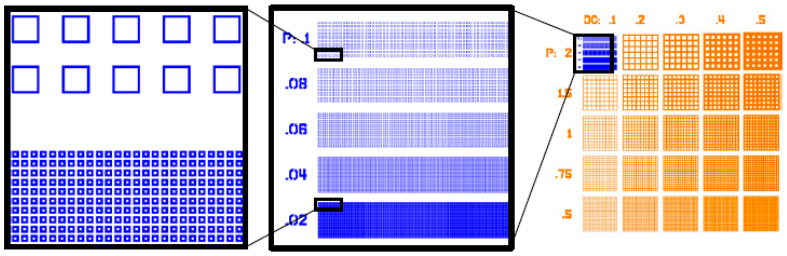
Iridium Line-doubling technique
(based on the smallest features – e.g. 10nm)





Iridium width (nm)	HSQ width (nm)	Structure pitch (nm)	Binary labeling
10	90	100	50
	70	80	40
	50	60	30
	30	40	20
	10	20	10

Pitch VS duty-cyle 2D grating: 1µm → 50 nm Au / 50nm → 10 nm Ir



XRnanotech是瑞士领先的高质量x射线光学元件制造商，从具有破纪录分辨率的高纵横比菲涅耳带片到超稳定的钻石光学元件和用于广泛x射线应用的定制3d纳米结构。众星联恒联合**XRnanotech**，为中国用户提供所有售前咨询，销售及售后服务，欢迎联系我们。

请联系我们
北京众星联恒科技有限公司

北京市海淀区信息路1号国1-2号楼B栋　　电话：+86-10-86467571　邮箱:sales@top-unistar.com